27 CEN 1883

POCCURCKAR AKAJEMUR HAYK

OPJEHA JEHUHA UHCTUTYT OEIJER

U HEOPTAHUYECKOR XUMUU XM., H.C.,KYPHÁKOBA

На правах рукописи

ЕГОРЫШЕВА Анна Владимировна

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕХОЛНЫХ МЕТАЛЛОВ Mn, Fe и Cu НА ФОТОИНДУЦИРОВАННЫЕ СВОИСТВА МОНОКРИСТАЛЛОВ Ві₁₂тіо₂₀

(02.00.04 - физическая химия)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук

Работа выполнена в ордена Ленина Институте общи неорганической химии им. Н.С.Курнаков РАН.

Научний руководитель - доктор химических нау профессор В.М.Скориков.

Официальные оппоненты: доктор технических на профессор В.А.Федоров; доктор химических на П.П.Федоров.

Ведущая организация — Научно-исследовательс физико-химический институт им. Л.Я.Карпова,г.Моск

1993

SAMUTA COCTOUTES 14 OKTOCAL

в 10 часов на заседании специализированно совета К 002.37.02 по присуждению ученой степи кандидата наук в ордена Ленина Институте общей неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН адресу: 117907, ГСП-1, Москва, Ленинский проспе

С диссертацией можно ознакомится в библиот ОХН РАН по адресу: Москва, Ленинский проспект, ЗІ

31.

Автореферат разослан Усессковы 1993

Ученый секретарь

специализированного совета

кандидат химических наук Э Э.Г.ЖУ

OBILAR XAPAKTEPUCTUKA PABOTH

Актуальность темы. Монокристалли со структурой типа силленита, одновременно обладают избирательной фоточувствительностью и линейным электрооптическим эффектом. Они находят широкое применение качестве фоторефрактивных сред, не уступая по своим свойствам таким известные материалы как Lindo, и Ватіо, Менее изученный BICMYTA Bi12TiO20 демонстрирует монокристалл титаната и внескую фоточувствительность электрооптические свойства сравнению с используемнии в настоящий момент силикатем Bi₁₂SiO_{2O} и германатом висмута Ві₁₂GeO₂₀, что определяет перспективность его применения.

Улучшение карактеристик устройств оптоэлектроники и дальнейшее расширение области применения этих кристаллов связано с целенаправленним изменением свейств за счет легирования. На примере других материалов било замечено, что легирование переходимих металлами группи железа существенно улучшает фоторефрактивние свейства. С другой сторони, внесение этих элементов приводит к появлению фотохромного эффекта, что в сочетании с фоторефрактивным эффектом сткрывает новые возможности для применения.

Оптимизация свойств материала для фоторефракции детального изучения процессов, происходящих в кристалле. В частности, необходимо иметь информацию о взеимодействии центров, примесью с решеткой кристалла, о механизме оптического возбуждения и время процессах переноса заряда. В 230 вопрос влиянии TO легирования переходними элементами груши железа на титаната рискута и их зависимость от концентрации вводимой примесипрактически не освещен в литературе.

Таким образом, проведение исследования по влиянию легирования переходными элементами группы келеза на фотоиндупированиме свойства титаната висмута является актуальной задачей как с научной, так и с практической точек зрения.

<u>Цель работи.</u> Целью данной работи является исследование влияния легирования переходными металлами на примере мл, Fe и Cu на оптические, фотохромние и фотоэлектрические свойства монокристаллов титаната висмута.

Для достижения поставленной цели решаются следующие конкретные задачи:

-получение монокристаллов ${\rm Bi}_{12}{\rm Tio}_{20}$, легированных ${\rm Mn}$, ${\rm Fe}$ и ${\rm Cu}$, методом вытягивания из раствора в расплаве;

-исследование влияния легирования в различних концентрациях на поглощение кристаллов $\mathrm{Bi}_{12}\mathrm{Tio}_{20}$, идентицикация полос поглощения примесных ионов, исследование их температурной зависимости и расчет соответствующих им сил осцилляторов;

-выяснение зарядового состояния и локального окружения вводимых в кристали примесей на основании сравнения экспериментально полученных данных с рассчитанными теоретически;

-изучение фотохромного эффекта в кристаллах $\mathrm{Bi}_{12}\mathrm{TiO}_{20}$, легированных ил. Fe и Cu, а также влияния на него различных термических обработок, исследование температурной зависимости термообесцвечивания, построение модели фотохромных превращений в кристаллах $\mathrm{Bi}_{12}\mathrm{TiO}_{20}$, содержащих ил, Fe, Cu;

-исследование дисперсии фоточувствительных свойств полученных материалов в зависимости от концентрации легирующей примеси, а также связи этих свойств с поглощением;

-нахождение дисперсии показателя преломления и величини электрооптического модуля \mathbf{r}_{41} кристаллов $\mathrm{Bi}_{12}\mathrm{TiO}_{20}$, а также влияния на них легирования Mn, Fe, Cu.

<u>Научная новизна.</u> Впервне проведено комплексное исследование влияния легирования переходними металлами на оптические, фотокромние, фотопроводящие и электрооптические свойства монокристаллов $3i_{12}$ тіо₂₀. Выполненное на одних и тех же кристаллах, в одинакових условиях, с учетом концентраций примеси в кристалле такое исследование позволяет создать объективную картину изменения свойств материала и их взаимосвязи.

Проведенные исследования влияния легирования Mn, Fe и Cu в различных концентрациях на коэффициент поглощения монокристаллов ві₁₂тіо₂₀ позволили предложить неразрушающий способ определения концентрации Mn и Fe в данном материале по величине поглощения в диапазоне концентраций 0.02-0.60 масс.% для Mn и 0.06-0.17 масс.% для Fe; показано, что отжиг в вакууме приводит к полной перезарядке ионов Mn и частичной — ионов Fe и Cu. Изучена температурная зависимость интенсивностей примесных полос поглощения.

Показан концентрационный характер фотохромного эффекта в $\mathrm{Bi}_{12}\mathrm{Tio}_{20}$, обусловленного вводимой примесью. Обнаружено совпадение полос возбуждения фотохромного эффекта для кристаллов, содержащих мл. Fe, Cu, свидетельствующее о единой природе генерации электронов в процессе перезарядки примеси. Изучено влияние отжига в вакууме на фотохромные свойства исследуемых кристаллов.

Установлени координационное окружение и зарядовое состояние легирукцих элементов. Предложени возможные механизмы перезарядки ионов примеси при засветке и отжиге в вакууме.

Методами термообесцвечивания и термостимулированной люминисценции найдены энергии активации процессов перезарядки, приводящих к релаксации фотохромного возбуждения.

Исследовано и объяснено влияние легирующих добавок на фоточувствительные свойства титаната висмута, показано, что с ростом концентрации примеси фототок падает в результате конкуренции двух процессов: поглощения, сопровождаемого d-d переходом в ионе примеси, и поглощения с последующей ионизацией электрона в зону проводимости. В области 2.4-2.8 эВ падение фототока связано с уменьшением времены жизни фотоносителей в результате захвата на примесные уровни.

Впервые измерена дисперсия показателя преломления монокристалля ${
m Bi}_{12}{
m TiO}_{20}$ в видимой области спектра. Уточнено значение электро-оптического модуля ${
m r}_{41}$ и показано, что его величина не зависит от длини волни падающего на образец света, а также от содержания примеси в кристалле в изученном концентрационном интервале.

Практическая значимость работи. Показана принципиальная возможность управления уровнем поглощения, фотохромного возбуждения и фоточувствительности при легировании монокристаллов $B1_{12}T10_{2C}$ переходными металлами мп. Ре. Си. что может бить использовано для получения фоторефрактивного материала с заданными свойствами. Даны рекомендации по использованию указанных примесей для создания новых фоторефрактивных устройств.

Предложен неразрушающий безэталонний метод определения содержания ионов ил и ге в монокристаллах ві₁₂тіо₂₀ по величине коэффициента поглощения в максимуме полосы, соответствующей d-d переходам указанных ионов, что позволяет определять содержание ил в диапазоне концентраций 0.02-0.60 и ге- 0.06-0.17 масс.%.

Показано преимущество специально нелегированных кристаллов $\mathrm{Bi}_{12}\mathrm{TiO}_{20}$, а также содержащих Mn, Fe, Cu в малых концентрациях, перед используемыми в настоящее время кристаллами $\mathrm{Bi}_{12}\mathrm{SiO}_{20}$ и $\mathrm{Bi}_{12}\mathrm{GeO}_{20}$ за счет большей электрооптической эффективности ($\mathrm{r}_{41}\mathrm{n}^3$) и высокой фоточувствительности.

Апробация работы и публикации. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на III Всесоюзной конференции по физико-химическим основам технологии сегнетоэлектрических и родственных материалов (Звенигород, 1988г.), а также на ежегодных конференциях молодых ученых ИОНХ РАН (в 1989, 1990, 1992 гг.). По теме диссертации опубликовано 5 печатных работы.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, нетирех глав, заключения и списка цитируемой литературы из 138 наименований. Работа изложена на 171 странице, содержит 46 рисунков и 17 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновивается актуальность вибранного направления ісследований, сформулировани цель, задачи, новизна и практическая ценность настоящей работы, приведены основные результаты и краткое юдержание последующих глав.

Первая глава представляет собой обзор литератури, в котором риводятся известные сведения о фазових равновесиях с участием ${\tt Bi_2O_3}$ оксидов ___зличних элементов, рассмотрены некоторые особенности ристаллической структуры И кристаллохимии соединений частности титаната висмута. Приведены изико-химические параметри кристаллов Ві₁₂ТіО₂₀. Рассматриваются птические, фотохромные и фотопроводящие свойства кристаллов со труктурой типа силленита, влияние на эти свойства легирования, в группы астности переходими элементами железа. Обсуждаются уществующие модели формирования дефектного центра, ответственного з "илечо" в спектре поглощения и фотопроводимости, а также модели OTOHMOGXOTC возбуждения. Рассматриваются электрооптические эфрактивные свойства исследуемых кристаллов. В конце обзора сделан ивод о необходимости исследования оптических, фотохромных и фоточектрических свойств кристаллов Bi₁₂TiO₂₀, содержащих переходные чементы грушим жэлеза в различных концентрациях, и создания модели, исивающей экспериментально полученные данные.

Вторая глава посвящена методическим аспектам работи. В ней исаны аппаратура, условия выращивания и исследования монокристалв, используемые в настоящей работе. Выращивание специально нелегированного и легированних монокристаллов Відатіодо проводи.

методом Чохральского из раствора в расплаве из полуторного оксил висмута и диоксида титана марки "ос.ч." при температурах 1115-1130 на установках омического нагрева с применением дополнительно тепловых экранов из 41_20_3 , что позволило снизить аксиальн температурный градиент до 8 град/см. Выбранные условия криста: лизации приводили к образованию атомно гладких граней, составляющ стационарную форму кристалла. При этом скорость витягивания и раствора в расплаве не превышала 1.2 мм/час, при скорости вращени 20-50 об./мин. Исходя из формы роста и морфологии поверхности фрон: кристаллизации, можно предположить, что витягивание монокристалли осуществляли в условиях анизотронного послойного механизма криста: лизации. Температура перегрева расплава не превышала 10-20°0 Легирование осуществляли добавлением к исходной шихте оксидо соответствующих элементов квалификации "ос.ч." в следующ концентрациях: $\mathbf{M}_{2}\mathbf{0}_{3}$ - 0.013-0.60 масс.%, $\mathbf{F}_{2}\mathbf{0}_{3}$ - 0.08-0.40 масс. сио - 0.10-0.30 масс. 3. Экспериментально установлена предельна концентрация u_{203} в расплаве, равная 0.60 масс.%, позволяюща получать качественные монокристаллы $\mathrm{Bi}_{12}\mathrm{TiO}_{20}$. Полученны специалы нелегированный, легированные Ми и Ре, а также легированные одновре менно си и Fe монокристалли Ві, Тіо, обозначенные в тексте к Bi, TiO, Cu. Рентгенофазовый анализ, проведенный на рентгеновском дифракт

Рентгенофазовый анализ, проведенный на рентгеновском дифракт метре "Geigerflex", показал, что все получение монокристал обладают структурой типа силленита. Приводятся значения параметр элементарной ячейки, плотности полученных кристаллов, измеренн гидростатическим взвешиванием, а также данные ЛМС и химическо анализов о концентрации легирующего элемента и других примесе Установленно, что содержание легирующего элемента превышало сумма

ную концентрацию примесей. Описываются процесс подготовки образцов к исследованиям, методики измерения и расчета.

В работе были использованы следующие установки: для изучения спектров пропускания и отражения в диапазоне 200-900 нм - спектрофотометр "Specord-N40", в диапазоне 0.8-2.5 мкм - "Hitachi-3400", Раман спектры снимали на лазерном спектрофотометре ДФС-24 с Λ аг-лазером (Λ = 5145.3129 Λ) (совместно с д.х.н. Н. Λ -Чумаевским ИОНХ РАН)

Исследования стационарной фотопроводимости, термообесцвечивания, термостимулированной лиминисценции, дисперсии показателя преломления и продольного электрооптического эффекта проводили на оригинальных установках, описания и блок-схемы которых приведены в работе.

<u>Третья и четвертая</u> главы посвящены описанию экспериментально и теоретически полученных результатов, а также их обсуждению.

Исследование влияния легирования Mn, Fe и Cu в различных концентрациях на коэффициент коглощения монокристаллов $\mathrm{Bi}_{12}\mathrm{TiO}_{20}$ в диапазоне длин волн 0.4-2.5 мкм показало, что при легировании на спектрах поглощения появляются полосы обусловленные, d-d переходами в примесных ионах, а также процессами переноса заряда (рис.1,2), что приводит к потемнению кристаллов в видимой области спектра. Положение максимумов этих полос было уточнено с помощью дифференциальных спектров пропускания, позволяющих получить информацию о недоступной для обичных спектров поглощения области вблизи края собственного поглощения (рис.3).

Установленно, что фотохромный эффект в кристаллах $\mathrm{Bi}_{12}\mathrm{TiO}_{20}$ носит объемный характер. Во всех исследуемых кристаллах, наряду с фотохромным эффектом наведенным ионами вводимой примеси, присутствует "собственный" фотохромный эффект, характерный для специально нелегированных кристаллов $\mathrm{Bi}_{12}\mathrm{TiO}_{20}$. Причем с увеличением содержания лигатуры в образце, происходит тушение "собственного" эффекта.

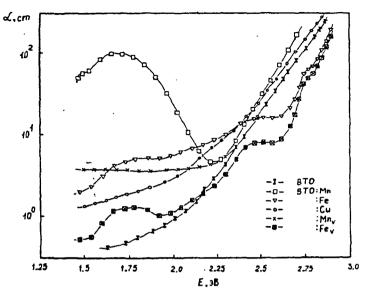


Рис.1. Спектры поглощения легированных кристаллов Bi_{12} TiO₂₀. v - указывает на отжиг в вакууме.

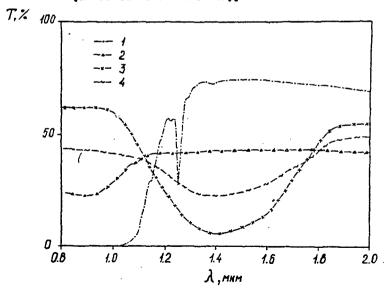


Рис.2. ИК-спектры пропускания $\mathrm{Bi}_{12}\mathrm{TiO}_{20}$, легированных: Mn - 1, Fe - 2, Cu - 3,4 - до и после засветки соответственно.

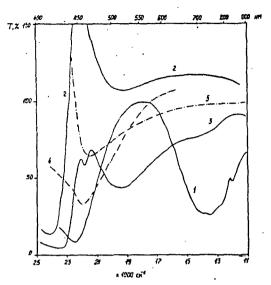


Рис.3. Дифференциальные спектры пропускания $\mathrm{Bi}_{12}\mathrm{Tio}_{20}$, содержащих: kn -1,4, Cu -2,5, Fe -3, относительно нелегировнного кристалла до облучения - 1,2,3 и облучения кристаллов относительно необлученных-4,5.

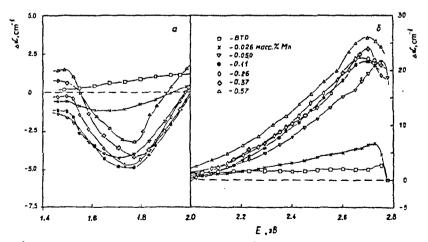


Рис.4. Спектри дополнительного поглощения $\mathrm{Bi}_{12}\mathrm{Tio}_{20}$:Ип; отрицательная область значений $\Delta\alpha$ – а, положительная – б.

Исследование полосы возбуждения фотохромного эффекта показало, что положение ее максимума при 2.4-2.5 эВ не зависит от состава и концентрации легирующих элементов, являясь одним и тем же для всех рассматриваемых образцов. Это свидетельствует о единой природе центра, играющего роль поставщика электронов в процессе переноса заряда, лежащего в основе фотохромного эффекта.

Применяя к исследуемым образцам различные методы воздействия (УФ-облучение, отжиг в вакууме и кислороде), удалось разделить наблюдаемые полосы на системы по природе их происхождения (табл.1). Показано, что при облучении светом из области максимума полосы возбуждения фотохромного эффекта на спектрах поглощения Відотіо появляется новая полоса при 2.7 эВ одновременно с уменьшением интенсивности полос при 1.7 и 2.8 эВ, что отчетливо проявляется на спектрах дополнительного поглощения в виде отрицательной области $\Delta \alpha$ (рис.4). После термовакуумного воздействия (t= 460°C, т= 3 часа) на Ві тіодо: Ми наблюдалось обесцвечивание образцов, спектр поглощения мало MUPULTO OT спектра специально нелегированного OTF свидетельствует о произошеттей В полной перезарядке ионов Mn. После отжига в тех же условиях кристаллов, содержащих Pe И Cu. Take обнаружено некоторое просветление образцов, особенно в области 2.95-3.00 эВ, интенсивность остальных полос при этом не изменялась. Спектр поглощения облученных светом Ві, тіо пе содержит HOBHX полос, проявляются только в увеличении интенсивности полосы при 0.99 эВ и некотором уменьшении поглощения в остальных полосах. Для кристаллов Bi, TiO, Cu облучение приводит K возникновению H8 спектрах диференциального поглощения новой интенсивной полосы при 2.66 вВ, а также к просветлению в области 0.89 эВ.

Таблица 1
Положение полос поглощения, обнаруженных в исследуемых ристаллах различными методами

·						
Материал	Спектры поглощения		Спектры дополнительного поглощения		Спектры дифференцивльного поглощения	
	см ⁻¹	эВ	см ^{—1}	эB	см ⁻¹	. 9B
BTO:Un	12000- 14500 [*]	1.48- 1.80 [*]	14100 [*]	1.75*	12000- 14500 [*] 22000 ^{**} 22900 [*]	1.48- 1.80* 2.73** 2.84*
BTO:Cu	7150*	0.89*	20150 21400 22200 23400	2.5 2.65 2.75 2.9	19800 21500 [*] *** 24000 ^{**}	2.45 2.67 ^{*,**} 2.97 ^{**}
BTO:Fe	8000 11100 14000 19800 21940	0.99 1.37 1.74 2.45 2.72	18800	2.33	13600 14400 19500 21800 23800	1.68 1.78 2.42 2.70 2.95*

^{* -} полоса исчезает после отжига в вакууме

^{* -} проявляется после засветки

Показана линейная концентрационная зависимость погложения в полосах при 1.7 9 В в 1 2 10 20: Ил и при 1.67 9 В в 1 2 10 20: Ре (рис.5). По формуле А.Смакули расчитани величини сил осцилляторов, соответствующие этим полосам. Их порядок 10 4 указывает на то, что данные переходы являются запрещенными по четности, разрешаемые с участием нечетных колебаний.

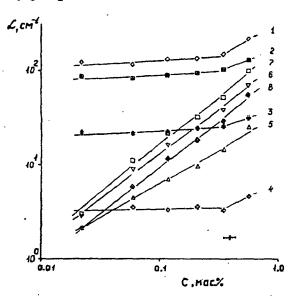


Рис.5. Концентрационная зависимость коэффициента поглощения Ві₁₂тіо₂₀: Ми для значений энергий падающего света: 2.73 -1, 2.68 -2, 2.50 -3, 2.23 -4, 1.98 -5, 1.83 -6, 1.67 -7, 1.49 эВ -8.

Изучение температурних зависимостей интенсивностей этих полос не обнаружило влияния температуры на величину поглощения в них, что свидетельствует о нецентросимметричном расположении ионов вводимой примеси, например тетраэдрическом.

Используя линейную зависисмость поглощения от содержания Mn и Fe в указанных полосах, были получени эмпирические формули для определения концентрации указанных элементов в интервалах 0.025-0.60 масс.% Ил и 0.06-0.20 масс.% Fe:

> $c = 0.062 \, \alpha^{0.99}$, (Macc.% Mn, E=1.70 9B); $c = 0.088 \, \alpha^{0.40}$, (Macc.% Fe, E=1.55 9B).

Подобние зависимости позволяют оценить содержание u_n и r_e в кристаллах u_{12}^{20} с точностью не хуже, чем при использовании традиционных химических и ЛМС методов, но без разрушения образца.

С помощью диаграмм Танабе-Сугано и полуэмиирического варианта теории кристаллического поля были найдены возможные положения полос поглощения ионов вводимой примеси во всех наиболее вероятных окружениях и зарядовых состояниях. Показано, что для иона мп, валентность которого может изменятся от 1 до 7, самые близкие к экспериментальным результаты получаются в случаях: иона мп $^{5+}$ в тетраэдрическом и октаэдрическом окружениях. Полосе, проявляющейся после облучения с максимумом при 2.7 эВ, лучше всего соответствует ион мп $^{3+}$. Для $^{3+}$ наиболее вероятные состояния $^{3+}$ $^{3+$

При исследовании Раман спектров образцов, содержащих ил, обнаружен пик при 740 см⁻¹, интенсивность которого увеличивается с ростом содержания ил и не наблюдаемый на спектрах специально нелегированного ві₁₂тіо₂₀. Исходя из имеющихся сведений о частотах наблюдаемых линий КРС в кристаллах со структурой типа силленита, а также в других материалах, содержащих ил известной валентности, показано, что найденную полосу следует отнести к колебаниям нормальной моди тетраздра по связям ил-о с зарядовым состоянием ил меньше 5+.

Рассчитана рентгеновская плотность исследуемых образцов по двум схемам замещения ионами переходных элементов в кристаллической решетке ${\rm Bi}_{12}{
m TiO}_{20}$: в тетраэдрических позициях вместо иона ${
m Ti}^{4+}$ и в

октаздрических вместо иона Bi^{3+} . Показано хорошее совпадения теоритических и экспериментальных результатов при условии вхождения ионов Mn , Fe и Cu в тетраэдрические позиции.

На основании нескольких независимих методов исследования расчета положения полос погложения, расчета рентгеновской плотности сравнения ее с экспериментальной, данных спектров КРС и температурного поведения интенсивности полос поглодения - показано что ионы мл. Ре и Си входят в кристали Відотіодо в тетраэдрически позиции. Ион ыл существует в двух зарядовых состояниях 4+ и 3+, преобладанием 4+ (как имеющее более устойчивую конфигурацию). Пр облучении светом из области возбуждения фотохромного эффект происходит перезарядка ионов $un^{4+} \rightarrow un^{3+}$. Роль донора в это процессе берет на себя дефектный центр, содержащий однократн заряженную вакансию по кислороду. При термовакуумном воздействии сопровождаемом образованием дополнительных кислородных вакансий, М также меняет свою валентность $Mn^{4+} \rightarrow Mn^{3+} \rightarrow Mn^{2+}$, что проявляетс в виде просветления кристалла, поскольку d-d переходы иона Mn² запрещены по спину и характеризуются величиной силы осциллятора н три порядка ниже, чем для иона мп⁴⁺. При последующем отжиге окислительной атмосфере ($t=400^{\circ}$ C, t=3Часа) ион Mn^{2+} переходит в 4валентное состояние. Показано, что из-за нарушений в анионно подрешетке, отжиг в вакууме сопровождается изменением веса образца величина которого совпадает с расчетной, необходимой для полнс перезарядки ионов мп4+.

Моны Fe в монокристаллах $\mathrm{Bi}_{12}\mathrm{TiO}_{20}$ также существуют в дву зарядовых состояниях Fe^{3+} и Fe^{2+} . Причем Fe^{2+} образуется за сче процесса переноса заряда с π -орбитали кислорода на Fe^{3+} . Перехс $\mathrm{Fe}^{3+} \longrightarrow \mathrm{Fe}^{2+}$ происходит и при засветие, однако новых полс поглощения при этом не возникает. Таким образом, фотохромный эффект обусловленный перезарядкой ионов Fe в кристаллах $\mathrm{Bi}_{1,2}\mathrm{TiO}_{20}$: 12 в

наблюдается, а уменьшение "собственного" фотохромного эффекта связано с внесением Ре мелких уровней, легко конизуемых при комнатной температуре.

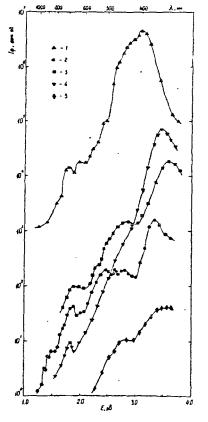
В кристаллах $\mathrm{Bi}_{12}\mathrm{TiO}_{20}$: Си, ион Cu^{2+} содержится наряду с ионами Fe^{3+} и Fe^{2+} . При облучении светом из области возбуждения фотохромного эффекта в образце происходят следующие процесси перезарядки: $\mathrm{Cu}^{2+} \longrightarrow \mathrm{Cu}^{+}$, $\mathrm{Fe}^{3+} \longrightarrow \mathrm{Fe}^{2+}$ и Cu^{4+} $\mathrm{Fe}^{3+} \longrightarrow \mathrm{Cu}^{2+}$ Fe^{2+} . Показано, что существованием последнего процесса и объясняется сильный фотохромный эффект в этих кристаллах.

Методами термообесцвечивания и термостимулированной лиминисценции найдены энергии активации центров захвата в специально нелегированном и содержащих мл. Ре и Со кристаллах, приводящих к стабилизации фотохромного возбуждения и участвующих в процессах перезарядки. Показано, что термообесцвечивание происходит ступенчатому закону, отражающему процесс опустошения центров захвата равномерно во всех полосах дополнительного поглощения, сопровождается появлением новых полос, что указывает на преобладание одного типа центров окраски. Основной вклад в восстановление поглощения образца вносит опустошение уровней с энергиями активации: для специально нелегированного Ві₁₂ТіО₂₀- 0.63-0.76 эВ, Ві₁₂ТіО₂₀: Ми 0.80-0.96 9B, Bi₁₂TiO₂₀:Fe - 0.34-0.40 9B, Bi₁₂TiO₂₀:Cu - 0.63-0.80 эВ.

Изучение кинетических зависимостей термообесцвечивания показало существование двух режимов в процессе релаксации фотохромного эффекта, что при условии преобладания одного типа центров окраски указывает на наличие двух различных механизмов рекомбинации. По данным термообесцвечивания, термостимулированной лиминисценции и спектров поглощения построена энергетическая диаграмма уровней в запрещенной зоне легированных кристаллов відоправных приведены

возможние модели переходов, сопровождажних возбуждение и релаксацию фотохромного эффекта.

Показано, что фотопроводимость в исследуемых кристаллах носит примесный карактер. В ее основе лежат переходы с уровней, участвующих в фотохромном возбуждении образцов. При легировании величина фототока в области d-d переходов резко падает (до 5 порядков в случае легирования Mn, до 4 порядков - Fe, до 2.5 порядков - Cu) с увеличением концентрации лигатури (рис.6) в результате конкуренции двух процессов поглощения: первого - сопровождаемого d-d переходом электрона и не приводящего к появлению свободного носителя заряда, и



второго - погложения с последующей ионизацией электрона в зону проводимости. В области, соответствующей полосе возбуждения фотохромного эффекта, уменьшение фототока связано с повышением вероятности рекомбинации носителей и уменьшением их времени жизни В SOHE свободных состояний. Изучена кинетика установления стационарного фототока. Определено энергетическое положение глубоких уровней. Показано, что при термовакуумном воздействии на образец происходит внутренняя пере-

Рис. 6. Спектральная зависимость фототока в нелегированном $\mathrm{Bi}_{12}\mathrm{TiO}_{20}$ (1) и легированных: 0.06 масс. % Fe-2, 0.13 масс. % Cu-3, 0.05 и 0.57 масс. % Mn-4,5 соответственно.

стройка кристалла, сказывающаяся на изменении концентрации глубоких и мелких уровней в запрещенной зоне кристалла, а также появлении нових с глубиной залегания 1.3-1.7 эВ.

Впервые получена дисперсионная зависимость показателя преломления $n(\lambda)$ специально нелегированного $\text{Bi}_{12}\text{TiO}_{20}$ (табл.2). Дисперсия показателя преломления носит нормальный характер. Значения n превосходят аналогичные для широко используемых в настоящее время монокристаллов $\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$ и $\text{Bi}_{12}\text{GeO}_{20}$ во всем исследуемом диапазоне.

Таблица 2 Зависимость показателя преломления ${\bf n}$ от длини волни ${\boldsymbol \lambda}$

λ,нм	n.	λ,HM	n
492	2.688	600	2.578
500	2.673	625	2.565
525	2.639	633	2.561
550	2.617	650	2.552
575	2.599	675	2.541
			<u> </u>

Погрешность измерения -1.10^{-3} единиц n.

Исследован продольний электрооптический эффект в специально нелегированном и легированных кристаллах $\mathrm{Bi}_{12}\mathrm{Tio}_{20}$. Оказалось, что величина электрооптического модуля r_{41} не зависит от длины волны проходящего света и его значение $5.9\cdot10^{-12}\,$ м/В больше аналогичных для $\mathrm{Bi}_{12}\mathrm{Sio}_{20}\,$ и $\mathrm{Bi}_{12}\mathrm{Geo}_{20}\,$, что в сочетании с высоким показателем преломления делает $\mathrm{Bi}_{12}\mathrm{Tio}_{20}\,$ более предпочтительным при использовании его в оптоэлектронике. Легирование переходными металлами группы железа в максимально полученных концентрациях не привело к изменению величины $\mathrm{r}_{41}\,$ (в пределах ошибки эксперимента, оцениваемой нами в

10%). Исходя из этого сделан вывод, что легирование данными элементами не ухудшает электрооптические свойства $\mathrm{Bi}_{12}\mathrm{TiO}_{20}$.

<u>В заключении</u> даны рекомендации по вероятному использованию полученных материалов, сформулированы основные результати и виводы. Они сводятся к следующему:

1. Полученни и исследованни физико-химическими методами монокристаллы твердых растворов Відгіого, содержащие Ми (0.02-0.60 масс.%), Ре (0.06-0.17 масс.%) и Си (0.03-0.12 масс.%). Установленно, что легирующие элементи Mn, Fe и Си входят в тетраэдрические позиции кристаллической решетки $\mathrm{Bi}_{12}\mathrm{TiO}_{20}$, замещая кон Ti^{4+} в следующих зарядовых состояниях: un^{4+} , Fe^{3+} и cu^{2+} , определяющих фотоиндуцированные свойства материала и изменяющихся при внешнем воздействии в результате процессов переноса заряда. Показано, что перезарядка ионов примеси при термовакуумной обработке: $\mathtt{Mn}^{4+} \longrightarrow$ $\mathtt{Mn}^{3+} \longrightarrow \mathtt{Mn}^{2+}$ и $\mathtt{Fe}^{3+} \longrightarrow \mathtt{Fe}^{2+}$ – сопровождается обесцвечиванием кристалла, а при УФ-облучении: в $\mathrm{Bi}_{12}\mathrm{TiO}_{20}$: Mn - Mn^{4+} — Mn^{3+} и в $Bi_{12}TiO_{20}$: Cu:Fe - Cu²⁺ \longrightarrow Cu⁺ Cu⁺ Fe³⁺ \longrightarrow Cu²⁺ Fe²⁺ - BH3HBaeT появление новых полос поглощения и фотохромного эффекта, в отличие от перехода ${\rm Fe}^{3+} \longrightarrow {\rm Fe}^{2+}$ в ${\rm Bi}_{4,2}{\rm TiO}_{2,0}$: Ре, приводящего к просветлению монокристалла. Обнаружено, что введение примеси в рассматриваемом концентрационном интервале приводит к падению фоточувствительности: в случае Візгіодо: Ми-на 5 порядков, Візгіодо: Fe-на 4 порядка, Ві 12 ТіО 20: Си- на 2.5 порядка. Это связано с повышением вероятности рекомбинации неравновесных носителей заряда и уменьшением их времени жизни, с одной стороны, и уменьшением квантового выхода в результате поглощения д-электронами ионов примеси, с другой. Создана общая картина изменения фотоиндуцированных свойств изученных кристаллов, что является необходимим для целенаправленного изменения свойств материала на основе титаната висмута.

- 2. Показано, что фотохромный эффект в специально нелегированном легированных кристаллах Ві₁₂Тіо₂₀ носит объемный характер. Обнаружено, что положение полоси возбуждения фотохромного эффекта не ависит от состава лигатури и является одной для всех образцов, что видетельствует о единой природе поставщика электронов.
- 3. Найдены энергии активации центров захвата, ответственных за отохромный эффект в легированных кристаллах $\mathrm{Bi}_{12}\mathrm{TiO}_{20}$. Показано, то процесс термообесцвечивания образцов идет по двум механизмам елаксации. Построена энергетическая диаграмма уровней в запрещенной оне кристаллов $\mathrm{Bi}_{12}\mathrm{TiO}_{20}$: Un.
- 4. Предложен неразрушающий метод определения содержания un и $ext{Fe}$ монокристаллах $\text{Bi}_{12}\text{Tio}_{20}$ с помощью концентрационной зависимости оэффициента поглощения.
- 5. Определены дисперсия показателя преломления и электроптический коэффициент \mathbf{r}_{41} монокристаллов $\mathbf{Bi}_{12}\mathbf{TiO}_{20}$, на основании оторых показано, что электрооптическая эффективность титаната исмута превосходит аналогичную величину для $\mathbf{Bi}_{12}\mathbf{SiO}_{20}$ и $\mathbf{Bi}_{12}\mathbf{GeO}_{20}$, то определяет большую перспективность его применения. Установленно, то легирование не ухудшает электрооптические свойства кристаллов $\mathbf{i}_{12}\mathbf{TiO}_{20}$.

Основные результаты диссертации опубликованы в следуищих аботах:

. Чмирев В.И., Егоришева А.В. Дисперсия показателя преломления и электрооптического коэффициента в монокристаллах титаната висмута $\text{Bi}_{12}\text{TiO}_{20}$ // В сб. тез. докл. III Всесоизной конференции по физико-химическим основам технологии сегнетоэлектрических и родственных материалов. Звенигород. 1988. С. 78.

- Скориков В.М., Чипрев В.М., Егорышева А.В., Волков В.В. Оптические и электрооптические свойства високосовершенных монокристаллог титаната еисмута (Ві₁₂ТіО₂₀) // Високочистие вещества. 1989. В. 2. С. 72-75.
- Скориков В.М., Чимрев В.И., Егоришева А.В., Волков В.В. Влияние
 легирования си на фотоэлектрические свойства монокристаллов
 відотіодо // Високочистие вещества. 1991. В. 2. С. 81-87.
- 4. Волков В.В., Егорынева А.В., Скориков В.М. Выращивание и некоторые физические свойства фаз типа силленита с ориентационног разупорядоченностью // Неорг. материалы. 1993. Т. 29. В. 5. С. 652-655.
- 5. Волков В.В., Егоришева А.В., Каргин D.Ф., Скориков В.М. Фотохромние центри в монокристаллах Ві₁₂тіо₂₀:Мп // Неорг. материали 1993. в печати.

Тир. 100 Зак. 374